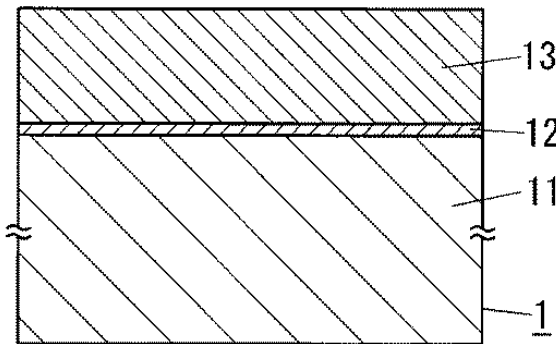


公開番号 又は 特許番号	特開 2014-53411
発明名称	エピタキシャルウェハ及びその製造方法
出願人 又は 権利者	パナソニック株式会社、独立行政法人理化学研究所、国立大学法人東京大学
想定デバイス	深紫外線高効率発光デバイス、エネルギーハーベスティング、その他
要約	【利用分野】シリコン基板上に形成される窒化アルミニウム薄膜の表面の平坦性の向上を図ることが可能なエピタキシャルウェハ及びその製造方法を提供する。 【発明の内容】エピタキシャルウェハ 1 は、シリコン基板 1 1 と、シリコン基板 1 1 の一表面側に形成された窒化アルミニウム薄膜 1 3 と、シリコン基板 1 1 と窒化アルミニウム薄膜 1 3 との間に設けられ窒化シリコンの形成を抑止するアルミニウム堆積物 1 2 とを備えている。
図面	 1 エピタキシャルウェハ 1 1 シリコン基板 1 2 アルミニウム堆積物 1 3 窒化アルミニウム薄膜